



ПРОТОН-ЭЛЕКТРОТЕКС

Высокая стойкость к
электротермоциклированию
Низкие статические и динамические потери
Разработан для промышленного
применения

Полупроводниковый Элемент Низкочастотного Диода Тип DR56-2000-18

Максимально допустимый средний прямой ток ¹⁾				I_{FAV}		2000 A		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение				U_{RRM}		1000...1800 В		
U_{RRM} , В	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800
Класс по напряжению	10	11	12	13	14	15	16	18
T_j , °C	-60...+190							

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

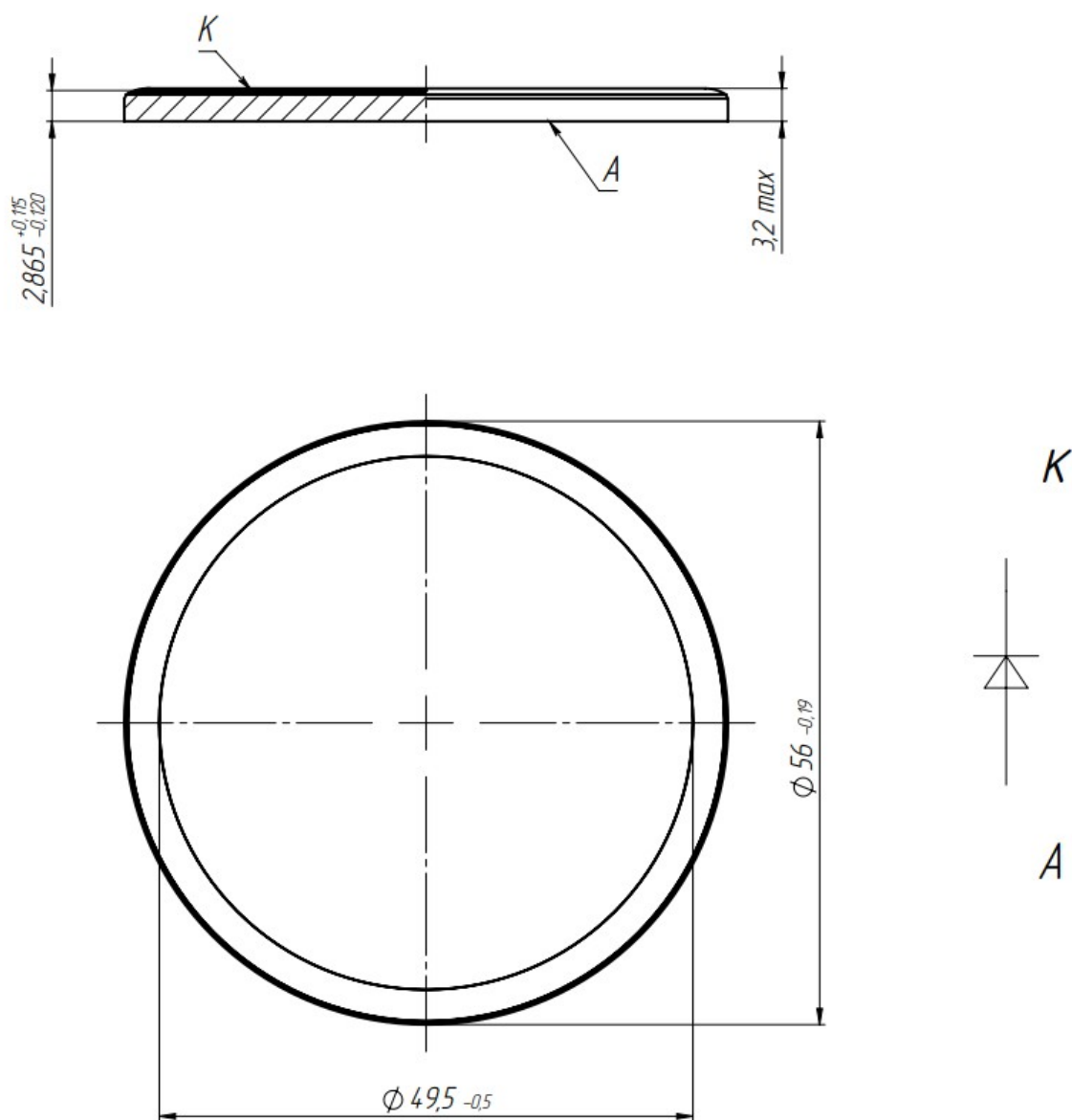
Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Параметры в проводящем состоянии					
I _{FAV}	Максимально допустимый средний прямой ток ¹⁾	A	2000 3013	T _c =139 °C; двухстороннее охлаждение; T _c =100 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{FRMS}	Действующий прямой ток ¹⁾	A	3140	T _c =139 °C; двухстороннее охлаждение; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
I _{FSM}	Ударный ток ¹⁾	кА	45.0 54.0	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =10 мс; единичный импульс; U _R =0 В
			47.0 56.0	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =8.3 мс; единичный импульс; U _R =0 В
I ² t	Защитный показатель ¹⁾	A ² с10 ³	10100 14500	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =10 мс; единичный импульс; U _R =0 В
			9100 13000	T _j =T _{j max} T _j =25 °C	180 эл. град. синус; t _p =8.3 мс; единичный импульс; U _R =0 В
Блокирующие параметры					
U _{RRM}	Повторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1000...1800	T _{j min} < T _j < T _{j max} ; 180 эл. град. синус; 50 Гц	
U _{RSM}	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение	В	1100...1900	T _{j min} < T _j < T _{j max} ; 180 эл. град. синус; единичный импульс	
U _R	Постоянное обратное напряжение	В	0.6·U _{RRM}	T _j =T _{j max}	
Тепловые параметры					
T _{stg}	Температура хранения	°C	−60...+50		
T _j	Температура р-п перехода	°C	−60...+190		
Механические параметры					
F	Монтажное усилие ¹⁾	кН	24.0...28.0		

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
Характеристики в проводящем состоянии					
U _{FM}	Импульсное прямое напряжение ¹⁾ , макс	В	1.55	T _j =25 °C; I _{FM} =6280 А	
U _{F(TO)}	Пороговое напряжение, макс	В	0.899	T _j =T _{j max} ; 0.5 π I _{FAV} < I _T < 1.5 π I _{FAV}	
r _T	Динамическое сопротивление ¹⁾ , макс	МОм	0.103		
Блокирующие характеристики					
I _{RRM}	Повторяющийся импульсный обратный ток, макс	мА	100	T _j =T _{j max} ; U _R =U _{RRM}	
Тепловые характеристики					
R _{thjc}	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус ¹⁾ , макс	°C/Вт	0.0180	Постоянный ток	Двухстороннее охлаждение
R _{thjc-A}			0.0396		Охлаждение со стороны анода
R _{thjc-K}			0.0324		Охлаждение со стороны катода
Механические характеристики					
m	Масса, макс	г	27.00		

МАРКИРОВКА				ПРИМЕЧАНИЕ
DR	56	2000	18	¹⁾ В зависимости от характеристик применяемого корпуса. Указанные значения актуальны при использовании корпуса Протон-Электротекс D.D2.
1	2	3	4	
1. ППЭ Низкочастотного Диода 2. Максимальный диаметр, мм 3. Средний прямой ток, А 4. Класс по напряжению				

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Все размеры в миллиметрах

Содержащаяся здесь информация является конфиденциальной и находится под защитой авторских прав.
В интересах улучшения качества продукции, АО «Протон-Электротекс» оставляет за собой право изменять информационные листы без уведомления.